



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Off nlegungsschrift
⑩ DE 100 20 464 A 1

⑤ Int. Cl.⁷:
H 01 L 33/00

⑳ Aktenzeichen: 100 20 464.3
㉑ Anmeldetag: 26. 4. 2000
㉒ Offenlegungstag: 8. 11. 2001

DE 100 20 464 A 1

㉓ Anmelder:
OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. oHG,
93049 Regensburg, DE

㉔ Vertreter:
Epping, Hermann & Fischer, 80339 München

㉕ Erfinder:
Härle, Volker, Dr., 93164 Laaber, DE; Bader, Stefan,
93053 Regensburg, DE; Hahn, Berthold, Dr., 93155
Hemau, DE; Lugauer, Hans-Jürgen, 93173
Wenzenbach, DE

㉖ Entgegenhaltungen:

DE 29 15 888 C2
DE 199 21 987 A1
DE 198 38 810 A1
DE 100 00 088 A1
DE 69 008 93 1T2
US 59 28 421 A
US 58 74 747 A
US 52 10 051 A
WO 92 13 363 A2

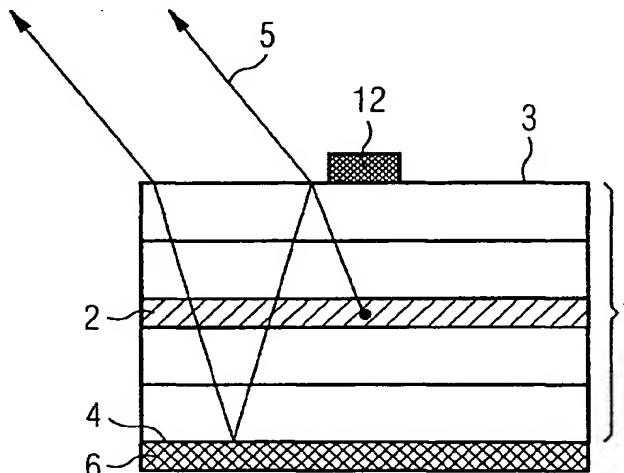
JP 10-150220 A (abstract), JPO, 1998;
JP 4-223330 A (abstract), JPO & Japio, 1992,
In: DOKIDX in DEPATIS;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉗ Strahlungsemitterndes Halbleiterbauelement auf GaN-Basis

㉘ Die Erfindung beschreibt ein strahlungsemitterndes Halbleiterbauelement auf GaN-Basis, dessen Halbleiterkörper durch einen Stapel unterschiedlicher GaN-Halbleiterschichten (1) gebildet ist. Der Halbleiterkörper weist eine erste Hauptfläche (3) und eine zweite Hauptfläche (4) auf, wobei die erzeugte Strahlung durch die erste Hauptfläche (3) ausgekoppelt wird und auf der zweiten Hauptfläche (4) ein Reflektor (6) ausgebildet ist. Weiterhin beschreibt die Erfindung ein Herstellungsverfahren für ein erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement. Dabei wird zunächst auf ein Substrat eine Zwischenschicht aufgebracht und auf diese eine Mehrzahl von GaN-Schichten (1), die den Halbleiterkörper des Bauelements bilden. Anschließend wird das Substrat und die Zwischenschicht abgelöst und auf einer Hauptfläche des Halbleiterkörpers ein Reflektor (6) ausgebildet.



DE 100 20 464 A 1

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein strahlungsemit-
tendes Halbleiterbauelement auf GaN-Basis nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Herstellungsverfahren
hierfür nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 8.

[0002] Strahlungsemitierende Halbleiterbauelemente auf
GaN-Basis sind beispielsweise bekannt aus US 5 210 051.
Solche Halbleiterbauelemente enthalten einen Halbleiter-
körper mit einer aktiven GaN-Schicht, die auf ein SiC-Sub-
strat aufgebracht ist. Kontaktiert ist der Halbleiterkörper
vorderseitig an der lichtauskoppelnden GaN-Schicht und
rückseitig an dem SiC-Substrat.

[0003] Weiterhin ist beispielsweise aus US 5 874 747 be-
kannt, statt GaN verwandte Nitride sowie darauf basierende
ternäre oder quaternäre Mischkristalle zu verwenden. Insbe-
sondere fallen hierunter die Verbindungen AlN, InN, Al-
GaN, InGaN, InAlN und AlInGaN.

[0004] Im folgenden bezieht sich die Bezeichnung "GaN"
auf diese ternären und quaternären Mischkristalle sowie
Galliumnitrid selbst.

[0005] Ferner ist bekannt, GaN-Halbleiterkristalle epitak-
tisch herzustellen. Als Substrat wird üblicherweise ein Sa-
phirkristall oder SiC verwendet. Gemäß US 5 928 421 ist
hinsichtlich der Vermeidung von Gitterfehlern ein SiC-Sub-
strat vorzuziehen, da aufgrund der vergleichsweise großen
Gitterfehlenganpassung zwischen Saphir und GaN die auf Sa-
phir aufgewachsenen GaN-Schichten eine hohe Anzahl von
Gitterfehlern aufweisen.

[0006] Ein Nachteil von strahlungsemitierenden GaN-
Halbleiterbauelementen besteht darin, daß an der Oberflä-
che, an der die im Halbleiterkörper erzeugte Strahlung aus-
gekoppelt wird, ein großer Brechungsindexsprung beim
Übergang vom Halbleiterkörper zur Umgebung auftritt. Ein
großer Brechungsindexsprung führt dazu, daß ein erhebli-
cher Teil der Strahlung wieder in den Halbleiterkörper zu-
rückreflektiert wird und dadurch die Strahlungsausbeute des
Bauelements gemindert wird.

[0007] Eine Ursache hierfür liegt in der Totalreflexion der
erzeugten Strahlung an der Auskoppelfläche. Lichtstrahlen
werden vollständig in den Halbleiterkörper zurückreflek-
tiert, falls der Einfallswinkel der Lichtstrahlen auf die Aus-
koppelfläche größer ist als der Totalreflexionswinkel, bezo-
gen jeweils auf die Oberflächennormale. Mit steigendem
Unterschied zwischen dem Brechungsindex des Halbleiter-
körpers und der Umgebung sinkt der Totalreflexionswinkel
und der Anteil der totalreflektierten Strahlung steigt.

[0008] Außerdem werden auch Lichtstrahlen, deren Ein-
fallswinkel kleiner ist als der Totalreflexionswinkel, teil-
weise in den Halbleiterkörper zurückreflektiert, wobei der
zurückreflektierte Anteil um so größer ist, je größer der Bre-
chungsindexunterschied zwischen Halbleiterkörper und
Umgebung ist. Ein großer Brechungsindexsprung, wie er
bei GaN-Bauelementen auftritt, führt daher zu großen Refle-
xionsverlusten an der Auskoppelfläche. Die zurückreflek-
tierte Strahlung wird teilweise im Halbleiterkörper absorbiert
oder tritt an einer anderen Fläche als der Auskoppelfläche
aus, so daß insgesamt die Strahlungsausbeute reduziert
wird.

[0009] Ein Mittel, die Strahlungsausbeute zu erhöhen, be-
steht darin, auf das Substrat des Halbleiterkörpers einen Re-
fektor aufzubringen. Dies ist beispielsweise in DE 43 05 296
gezeigt. Dadurch wird die in den Halbleiterkörper zurückreflek-
tierte Strahlung wiederum in Richtung der Auskoppelfläche
gerichtet, so daß der zurückreflektierte Teil der Strahlung
nicht verlorengeht, sondern zumindest teilweise nach einer
oder mehreren internen Reflexionen

ebenfalls ausgekoppelt wird.

[0010] Bei strahlungsemitierenden GaN-Bauelementen
nach dem Stand der Technik ist es in dieser Hinsicht von
Nachteil, ein absorbierendes Substrat wie beispielsweise
SiC zu verwenden. Die in den Halbleiterkörper zurückre-
flektierte Strahlung wird vom Substrat großteils absorbiert,
so daß eine Erhöhung der Strahlungsausbeute mittels eines
Reflektors nicht möglich ist.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde, ein Halbleiterbauelement auf GaN-Basis mit erhöh-
ter Lichtausbeute zu schaffen. Weiterhin ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung sol-
cher Halbleiterbauelemente zu entwickeln.

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauele-
ment nach Anspruch 1 beziehungsweise ein Herstellungsver-
fahren nach Anspruch 8 gelöst.

[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 7. Die Unteransprüche
9 bis 17 geben vorteilhafte Ausführungsformen des Herstel-
lungsverfahrens nach Anspruch 8 an.

[0014] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, das strahlungse-
mitierende Halbleiterbauelement auf GaN-Basis als
Dünnschichtbauelement auszubilden, das insbesondere kein
strahlungsabsorbierendes Substrat aufweist. Der Halbleiter-
körper des Bauelements ist von einer stapelförmig angeord-
neten Mehrzahl unterschiedlicher Schichten auf GaN-Basis
gebildet. Im Betrieb erzeugt eine aktive Halbleiterschicht
auf GaN-Basis elektromagnetische Strahlung, die durch
eine erste Hauptfläche des Stapels ausgekoppelt wird. Auf
eine zweite Hauptfläche des Stapels ist ein Reflektor aufge-
bracht, so daß der Teil der Strahlung, der bei der Auskopp-
lung zunächst in den Halbleiterkörper zurückreflektiert
wird, mittels dieses Reflektors wieder in Richtung der Aus-
koppelfläche gerichtet wird.

[0015] Damit wird neben dem primär ausgekoppelten An-
teil der erzeugten Strahlung ein weiterer Teil nach einer oder
mehreren internen Reflexionen an dem Reflektor ausgekop-
pelt. Insgesamt wird so der Auskopplungsgrad gegenüber
einem GaN-Halbleiterbauelement nach dem Stand der Tech-
nik erhöht.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform bestehen
die GaN-basierenden Halbleiterschichten aus GaN, AlN,
InN, AlGaIn, InGaIn, InAlIn oder AlInGaIn. Durch Verwen-
dung dieser Materialien kann die Zentralwellenlänge der er-
zeugten Strahlung in einem weiten Bereich des sichtbaren
Spektralbereichs bis in den ultravioletten Spektralbereich
eingestellt werden. Mit der vorliegenden Erfindung können
so mit besonderem Vorteil blaue und grüne Leuchtdioden,
UV-Leuchtdioden sowie entsprechende Laserdioden reali-
siert werden.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform
kann der Reflektor durch eine metallische Kontaktfläche
ausgebildet sein. Diese dient sowohl als Reflektor als auch
zur elektrischen Kontaktierung des Halbleiterkörpers. Vor-
teilhafterweise sind bei dieser Ausführungsform reflektor-
seitig keine weiteren Vorrichtungen zur Kontaktierung des
Halbleiterkörpers nötig. Als Material für die Kontaktflächen
eignen sich besonders Al und Ag sowie Al- und Ag-Legie-
rungen.

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform
ist der Reflektor durch eine dielektrische Verspiegelung aus-
gebildet. Eine solche Verspiegelung kann durch Aufbrin-
gung einer Schichtenfolge aus SiO₂ bzw. TiO₂ auf den Hal-
bleiterkörper hergestellt sein. Mit dielektrische Verspiegelun-
gen kann vorteilhafterweise eine verlustfreie Reflexion in
einem breiten Wellenlängenbereich erzielt werden.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
ist die gesamte freie Oberfläche des Halbleiterkörpers oder

ein Teilbereich davon aufgerauht. Durch diese Aufrauung wird die Totalreflektion an der Auskoppelfläche gestört und dadurch mit Vorteil der optische Auskopplungsgrad weiter erhöht.

[0020] Bei dem erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren wird zunächst auf ein Substrat eine Zwischenschicht aufgebracht. Auf dieser Zwischenschicht wird eine Mehrzahl unterschiedlicher, GaN-basierender Halbleiterschichten abgeschieden. Diese Schichten auf GaN-Basis bilden den Halbleiterkörper des Bauelements. Im nächsten Schritt wird von dem so gebildeten Stapel von GaN-basierenden Schichten das Substrat einschließlich der Zwischenschicht abgelöst. In einem weiteren Schritt wird auf eine der beiden Hauptflächen des Halbleiterkörpers ein Reflektor aufgebracht.

[0021] Bei einer weiteren Ausführungsform wird ein Si-Substrat verwendet, auf das eine SiC-Zwischenschicht aufgebracht ist. SiC eignet sich besonders für die Herstellung von GaN-Bauelementen, da es eine ähnliche Gitterkonstante wie GaN besitzt, so daß auf SiC abgeschiedene Schichten auf GaN-Basis eine geringe Zahl von Gitterfehlern aufweisen.

[0022] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform wird die Zwischenschicht mittels eines Waferbonding-Verfahrens aufgebracht und danach abgedünnt. Bei der Verwendung eines Si-Substrats und einer SiC-Zwischenschicht kann vorteilhafterweise der Si-Wafer mit dem SiC-Wafer durch Ausbildung einer SiO₂-Schicht verbunden werden.

[0023] Alternativ kann die Zwischenschicht epitaktisch aufgewachsen werden, wodurch besonders homogene Zwischenschichten herstellbar sind.

[0024] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der Reflektor durch Aufbringung eines spiegelnden Metallkontakts auf den GaN-Halbleiterkörper ausgebildet. Als Materialien für den Metallkontakt eignen sich aufgrund ihrer Reflektivität sowie ihrer Bond-Eigenschaften besonders Ag und Al sowie Ag- und Al-Legierungen.

[0025] Eine weiteren Ausführungsform des Herstellungsverfahrens besteht darin, den Reflektor als dielektrischen Spiegel in Form einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten auszubilden, woraus sich die oben beschriebenen Vorteile eines dielektrischen Reflektors ergeben.

[0026] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung wird das Herstellungsverfahren fortgeführt durch eine Aufrauung des Halbleiterkörpers, wobei die gesamte freie Oberfläche des Halbleiterkörpers oder Teilbereiche hiervon aufgerauht werden. Eine bezüglich der Erhöhung der Lichtausbeute besonders effektiver Aufrauung wird durch Anätzen des Halbleiterkörpers oder mittels eines Sandstrahlverfahrens hergestellt.

[0027] Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform wird vor dem Abscheiden der GaN-Schichten auf der Zwischenschicht eine Maskenschicht aufgebracht. Diese Maskenschicht strukturiert die GaN-Schichten und teilt insbesondere die GaN-Schichten in mehrere, nicht zusammenhängende Bereiche. Dies verhindert mit großem Vorteil Ribbildung und Ablösung der Zwischenschicht vom Substrat. Vorteilhafterweise wird – insbesondere bei Verwendung von SiC als Zwischenschichtmaterial – als Maske eine Oxidmaske ausgebildet.

[0028] Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von vier Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 bis 4. Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements,

[0030] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements,

[0031] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens und

[0032] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens.

[0033] Das in Fig. 1 dargestellte strahlungsemitierende Halbleiterbauelement weist eine Mehrzahl von stapelförmig angeordneten, unterschiedlichen Halbleiterschichten 1 auf, die aus GaN oder einer darauf basierenden ternären oder quaternären Verbindung bestehen. Im Betrieb bildet sich innerhalb dieser Schichten eine aktive Zone 2 aus, in der die Strahlung 5 generiert wird.

[0034] Der Schichtstapel wird von einer ersten Hauptfläche 3 und einer zweiten Hauptfläche 4 begrenzt. Im wesentlichen wird die erzeugte Strahlung 5 durch die erste Hauptfläche 3 in die angrenzende Umgebung ausgekoppelt.

[0035] Auf der zweiten Hauptfläche 4 ist ein Reflektor 6 aufgebracht, gebildet von einer direkt auf den Halbleiterkörper aufgedampften Ag-Schicht. Kontaktiert wird der Halbleiterkörper auf der Auskopplungsseite über die Kontaktfläche 12 sowie reflektorseitig über die Ag-Reflektorschicht. Die reflektorseitige Kontaktierung kann beispielsweise dadurch erfolgen, daß der Halbleiterkörper reflektorseitig auf einen Metallkörper aufgesetzt ist, der sowohl als Träger wie auch der Stromzuführung dient.

[0036] Der Reflektor 6 bewirkt, daß ein Teil der Strahlung 5, die bei der Auskopplung an der ersten Hauptfläche 3 in den Halbleiterkörper zurückreflektiert wird, wiederum in Richtung der ersten Hauptfläche 3 reflektiert wird, so daß insgesamt die durch die erste Hauptfläche 3 ausgekoppelte Strahlungsmenge erhöht wird. Diese Erhöhung wird dadurch ermöglicht, daß das Bauelement als Dünnschichtbauelement ohne strahlungsabsorbierendes Substrat ausgeführt ist und der Reflektor 6 direkt auf dem GaN-Halbleiterkörper aufgebracht ist.

[0037] Das in Fig. 2 dargestellte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelement unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten Bauelement darin, daß die Oberfläche des Halbleiterkörpers eine Aufrauung 7 aufweist. Diese Aufrauung 7 bewirkt eine Streuung der Strahlung 5 an der ersten Hauptfläche 3, so daß die Totalreflexion an der ersten Hauptfläche 3 gestört wird. Weitergehend verhindert diese Streuung, daß die erzeugte Strahlung durch fortlaufende, gleichartige Reflexionen zwischen den beiden Hauptflächen 3 und 4 bzw. dem Reflektor 6 nach Art eines Lichtleiters geführt wird, ohne den Halbleiterkörper zu verlassen. Somit wird durch die Aufrauung 7 die Lichtausbeute weiter erhöht.

[0038] In Fig. 3 ist ein erste Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens gezeigt. Den Ausgangspunkt stellt ein Si-Substrat 8 dar, Fig. 3a. Auf dieses Si-Substrat wird in einem ersten Schritt eine SiC-Zwischenschicht 9 mittels eines Waferbonding-Verfahrens aufgebracht, wobei zwischen den beiden Substraten eine SiO₂-Schicht 10 ausgebildet wird, Fig. 3b. Im nächsten Schritt wird das SiC-Substrat 9 bis auf wenige Mikrometer abgedünnt, Fig. 3c. Auf dem abgedünnten SiC-Substrat 9 wird epitaktisch mittels eines MOCVD-Verfahrens eine Mehrzahl unterschiedlicher GaN-Halbleiterschichten 1 abgeschieden, die den Halbleiterkörper des erfindungsgemäßen Bauelements bilden, Fig. 3d. Nach der Herstellung des GaN-Schichtstapels wird das Si-Substrat 9 sowie die SiC-Zwischenschicht 10 entfernt, Fig. 3e. Danach wird auf eine Hauptfläche 4 des GaN-Halbleiterkörpers eine spiegelnde

metallische Kontaktfläche 6, bestehend aus einer Ag- oder Al-Legierung, aufgedampft, Fig. 3f.

[0039] Um Totalreflexion an der ersten Hauptfläche 3 zu mindern, kann anschließend der Halbleiterkörper durch ein Sandstrahlverfahren oder durch Anätzen mit einer geeigneten Ätzmischung aufgeraut werden.

[0040] Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens verläuft bis einschließlich des Abdünnens des SiC-Substrats 10 (Fig. 4a bis Fig. 4c) analog zu dem oben beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel. Im Unterschied dazu wird vor dem Abscheiden der GaN-Schichten 1 eine Oxidmaske 11 auf die SiC-Schicht 10 aufgebracht, Fig. 4d. Diese Oxidmaske 11 bewirkt, daß im nächsten Schritt die GaN-Schichten 1 nur auf den von der Maske nicht bedeckten Teilbereichen der SiC-Zwischenschicht aufwachsen.

[0041] Da die so gebildeten GaN-Schichten 1 entlang der Schichtebene unterbrochen sind, werden Verspannungen, die auf den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von SiC und GaN beruhen und vor allem bei Abkühlen des Bauelements nach der Herstellung entstehen, vermindert. Dies führt vorteilhafterweise zu einer geringeren Rißbildung in den GaN-Schichten 1 und unterbindet eine Delamination der SiC-Zwischenschicht 9 vom Substrat. Die Herstellung des Reflektors 6, Fig. 4g, erfolgt wie oben beschrieben.

[0042] Die Erläuterung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements und des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens anhand der oben beschriebenen Ausführungsbeispiele ist natürlich nicht als Beschränkung der Erfindung zu betrachten. Insbesondere unterliegt Zusammensetzung und die Dimensionierung des GaN-Schichtstapels hinsichtlich der Ausbildung einer Leuchtdioden- oder Laserstruktur keinen weiteren Einschränkungen.

Patentansprüche

1. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement, dessen Halbleiterkörper durch einen Stapel unterschiedlicher Halbleiterschichten auf GaN-Basis (1) gebildet ist und der eine erste Hauptfläche (3) und eine zweite Hauptfläche (4) aufweist, wobei wenigstens ein Teil der erzeugten Strahlung (5) durch die erste Hauptfläche (3) ausgekoppelt wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß auf die zweite Hauptfläche (4) ein Reflektor (6) aufgebracht ist.
2. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterschichten (1) aus GaN, AlN, InN, AlGaIn, InGaIn, InAlN oder AlInGaIn bestehen.
3. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (6) durch eine spiegelnde, metallische Kontaktfläche gebildet ist.
4. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfläche aus Ag, Al oder einer Ag- oder Al-Legierung besteht.
5. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (6) durch eine dielektrische Verspiegelung ausgebildet ist.
6. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Verspiegelung durch eine Mehrzahl von dielektrischen Schichten gebildet ist.
7. Strahlungsemitierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daß die gesamte freie Oberfläche des Halbleiterkörpers oder ein Teilbereich davon aufgeraut ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemitierenden Halbleiterbauelements, dessen Halbleiterkörper durch einen Stapel unterschiedlicher Halbleiterschichten auf GaN-Basis (1) gebildet ist und der eine erste Hauptfläche (3) und eine zweite Hauptfläche (4) aufweist, wobei wenigstens ein Teil der erzeugten Strahlung (5) durch die erste Hauptfläche (3) ausgekoppelt wird und die zweite Hauptfläche (4) einen Reflektor (6) aufweist, gekennzeichnet durch die Schritte

- Aufbringen einer Zwischenschicht (9) auf ein Substrat (8)
- Aufbringen einer Mehrzahl unterschiedlicher GaN-Schichten (1) auf die Zwischenschicht (9)
- Ablösen des Substrats (8) einschließlich der Zwischenschicht (9)
- Aufbringen des Reflektors (6) auf die zweite Hauptfläche (4) des GaN-Halbleiterkörpers.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Substrat (8) ein Si-Substrat verwendet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine SiC-Zwischenschicht aufgebracht wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenschicht (9) durch ein Waferbonding-Verfahren aufgebracht wird.

12. Verfahren nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenschicht (9) epitaktisch aufgebracht wird.

13. Verfahren nach Anspruch 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (6) durch Aufbringen einer Metallschicht gebildet wird, die zugleich der Kontaktierung des Halbleiterkörpers dient.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß vor Herstellung der GaN-Schichten (1) auf die Zwischenschicht (9) eine Maske (11) aufgebracht wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper aufgeraut wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper durch Ätzen aufgeraut wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper durch ein Sandstrahlverfahren aufgeraut wird.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

FIG 1

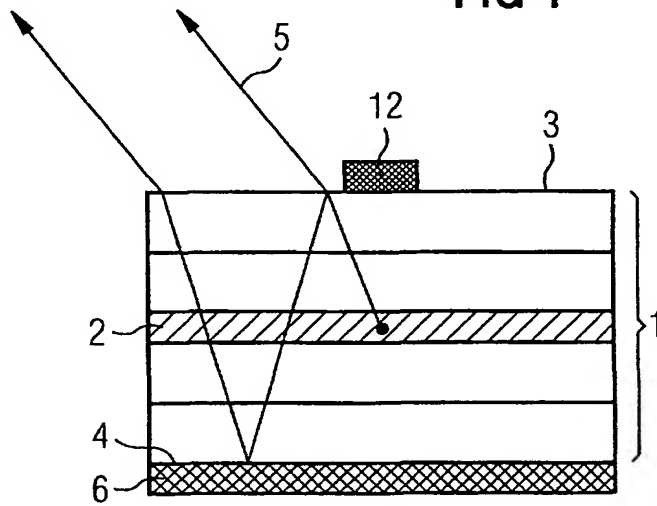


FIG 2

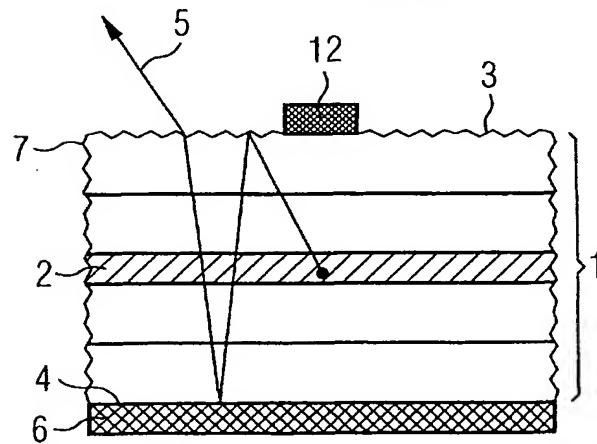


FIG 3A

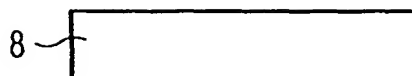


FIG 3B

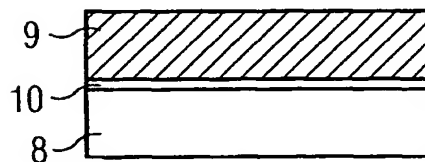


FIG 3C

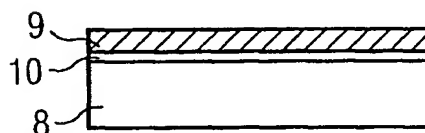


FIG 3D

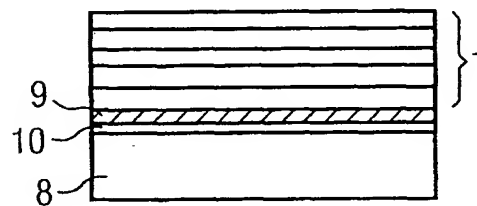


FIG 3E

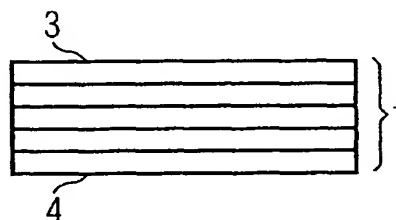


FIG 3F

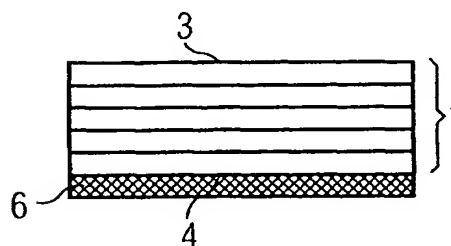


FIG 4A



FIG 4B

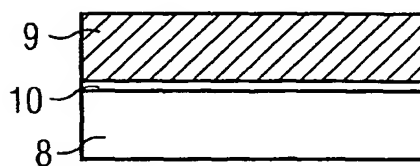


FIG 4C

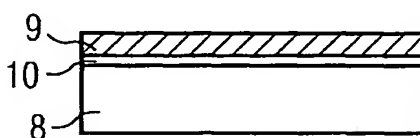


FIG 4D

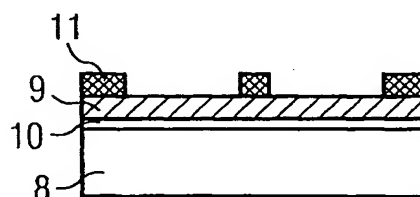


FIG 4E

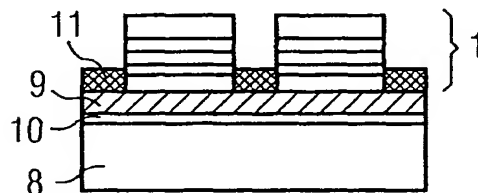


FIG 4F

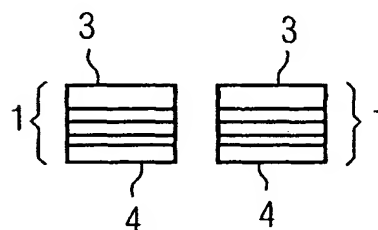


FIG 4G

